

Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники
Председателю диссертационного совета 212.268.04
на базе Томского государственного университета
систем управления и радиоэлектроники, д.т.н.,
профессору Шандарову С.М.

634050, г. Томск, пр. Ленина 40

Уважаемый Станислав Михайлович!

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом по диссертационной работе Федина Ивана Владимировича «Мощные быстродействующие диоды на основе гетероэпитаксиальных структур нитрида галлия» по специальности 01.04.04 – физическая электроника, на соискание учёной степени кандидата технических наук. Сведения, необходимые для размещения на сайте ТУСУР, прилагаются.

Заведующий 42 лабораторией 4 отдела АО «НИИПП», кандидат физико-математических наук

 / О.Ю. Малаховский

Приложение: Сведения об официально оппоненте на 2 стр. в 1 экз.

Подпись Малаховского О.Ю. удостоверяю
Начальник отдела кадров

 / М.В. Курсенко



Сведения об официальном оппоненте

по диссертационной работе Федина Ивана Владимировича «Мощные быстродействующие диоды на основе гетероэпитаксиальных структур нитрида галлия» по специальности 01.04.04 – физическая электроника, на соискание учёной степени кандидата технических наук.

Фамилия, имя, отчество	Малаховский Олег Юрьевич
Учёная степень (с указанием шифра и наименования научной специальности, по которой защищена диссертация)	Кандидат физико-математических наук, специальность 01.04.10 – физика полупроводников и диэлектриков
Учёное звание (по кафедре, специальности)	-
Основное место работы	
Должность	Начальник лаборатории
Наименование подразделения (кафедра, лаборатория)	42 лаборатория 4 отдела
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Акционерно общество «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов»
Почтовый индекс, адрес, веб-сайт, телефон, адрес электронной почты организации	Россия, 634034, г. Томск, ул. Красноармейская 99а, https://www.niipp.ru/ , Тел. (3822) 555-089, niipp@niipp.ru
Публикации по специальности 01.04.04 – физическая электроника (4-5 за последние 5 лет, в том числе обязательно указание публикаций за последние 3 года)	
1) Малаховский О.Ю. Неквазистатическая модель р-п-перехода без рекурсии на пользовательском уровне / Семёнов Э.В., Малаховский О.Ю. // Известия ВУЗ. Физика. – 2019 – Т. 62, № 6. – С. 151 – 156.	
2) Малаховский О.Ю. Измерение больших значений добротности емкостных объектов прямым методом с использованием специальной калибровки измерителя импеданса / Семёнов Э.В., Малаховский О.Ю. // Доклады ТУСУР. – 2018. – Т. 21, № 4. – С. 11 – 16.	
3) Малаховский О.Ю. Неквазистатическая модель диода с учетом токов экстракции и рекомбинации неравновесных носителей заряда / Семенов Э.В., Малаховский О.Ю. // Доклады ТУСУР. - 2019. - Т. 22, N 4. - С. 11-16.	
3) Пат. RU2016102532А РФ, МПК H01L 21/28. Способ изготовления варикапа с обратным градиентом [Текст] / С. М. Гушин, О. Ю. Малаховский,	

Е. В. Скробов, Л. В. Фотина, Н. В. Скотников; заявитель и патентообладатель АО «НИИПП». - № 2016102532; заявл. 26.01.16; опубл. 31.07.2017, Бюл. № 22.

4) Malakhovskij O.Yu. Non-Quasi-Static p-n Junction Model Without User-Defined Recursion / Semyonov E.V., Malakhovskij O.Yu. // Russian Physics Journal. - 2019. - V. 62, No. 6. - P. 1090-1095.

5) Malakhovskij O. Yu. Isothermal measurement of the current-voltage characteristics of Gunn diodes with emphasis of their discontinuities and hysteresis / Semyonov E.V., Malakhovskij O. Yu. // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо '2019). – Севастополь. - 8-14 сентября 2019 г.